

a 2016 0074

Invenția se referă la tehnologia semiconductorilor și poate fi utilizată la dispozitive de conversie a radiației solare. Procedul de creștere a structurii n⁺-p-p⁺InP pentru celule solare include creșterea stratului epitaxial pInP pe un substrat de p⁺InP cu orientarea cristalografică (100), deorientarea de 3...5° în direcția (110) și concentrația purtătorilor de sarcină de 1...3·10¹⁸ cm⁻³, creșterea stratului epitaxial de n⁺InP și depunerea contactelor ohmice. Stratul n⁺InP este crescut după corodarea gazoasă a reactorului și a stratului epitaxial de pInP.

Revendicări: 1